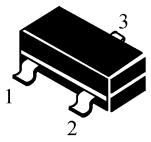
KEL®

M28S

KEL M28S

SOT—23

1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR



■FEATURES 特點

High h_{FE} 高放大倍數

NPN silicon NPN

■MAXIMUM RATINGS 最大定額值(T_a=25℃)

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	40	V
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	20	V
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	5	V
Collector Current-Pulse 集電極電流-脉冲	Ic	1000	mA
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P_C	300	mW
Junction Temperature 結溫	T_j	150	℃
Storage Temperature Range 儲存溫度	T_{stg}	-55～150	℃

■DEVICE MARKING 打標

M28S=28S.
300~600 500~700 600~1200

KEL®

M28S

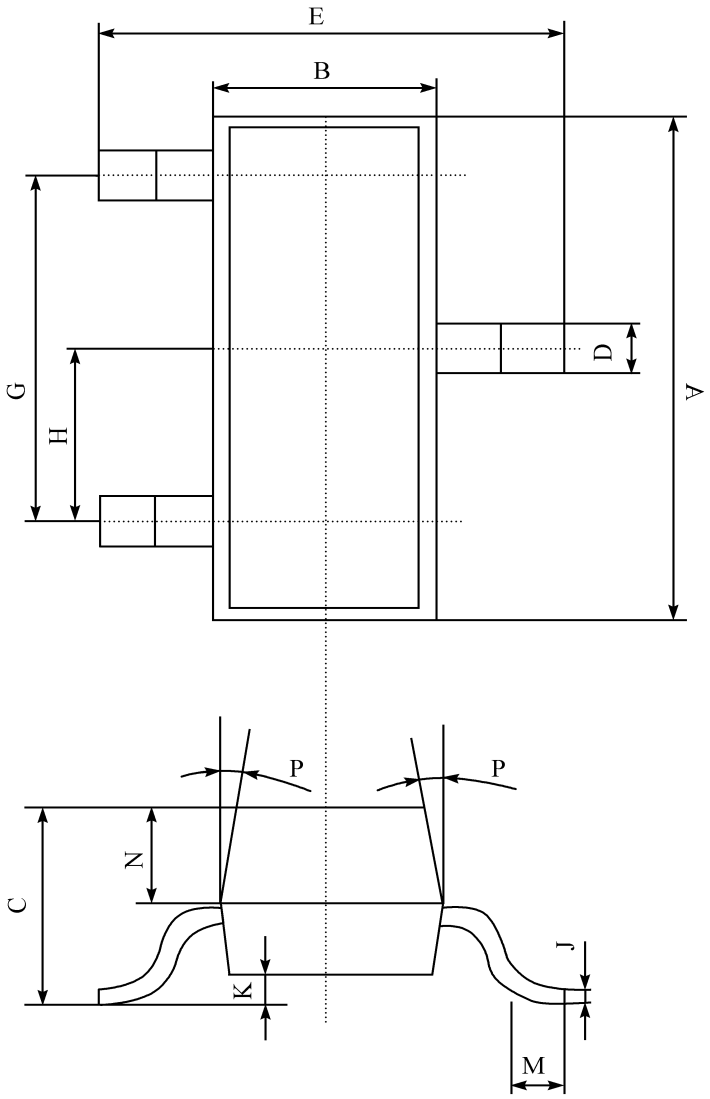
■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

（T_A=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度爲 25℃ **）**

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min. 最小值	Typ. 典型值	Max. 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	V_{CB}=25V,I_E=0	—	—	100	nA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	V_{EB}=5V,I_C=0	—	—	100	nA
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	I_C=100 μ A	40	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	I_C=1mA	20	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	I_E=100 μ A	5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	h_{FE}	V_{CE}=1V, I_C=100mA	300	—	1200	—
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	V_{CE}=5V,I_C=10mA	—	120	—	MHz
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	I_C=600mA, I_B=20mA	—	—	0.55	V

M28S

■DIMENSION 外形封裝尺寸



序號	數值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.2
N	0.60±0.10
P	7±2°